

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. Februar 2005 (03.02.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/010983 A2

(51) Internationale Patentklassifikation: H01L 21/8247

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DI2004/001588

(22) Internationales Anmeldedatum:
21. Juli 2004 (21.07.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 33 557.9 23. Juli 2003 (23.07.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KUND, Michael
[DI/DE]; Erlenweg 6, 83104 Tuntenhausen (DE). MIKO-
LAJICK, Thomas [US/DE]; Liebigstr. 18, 01069
Dresden (DE). PINNOW, Cay-Uwe [DI/DE]; Revaler
Str. 16, 81677 München (DE).

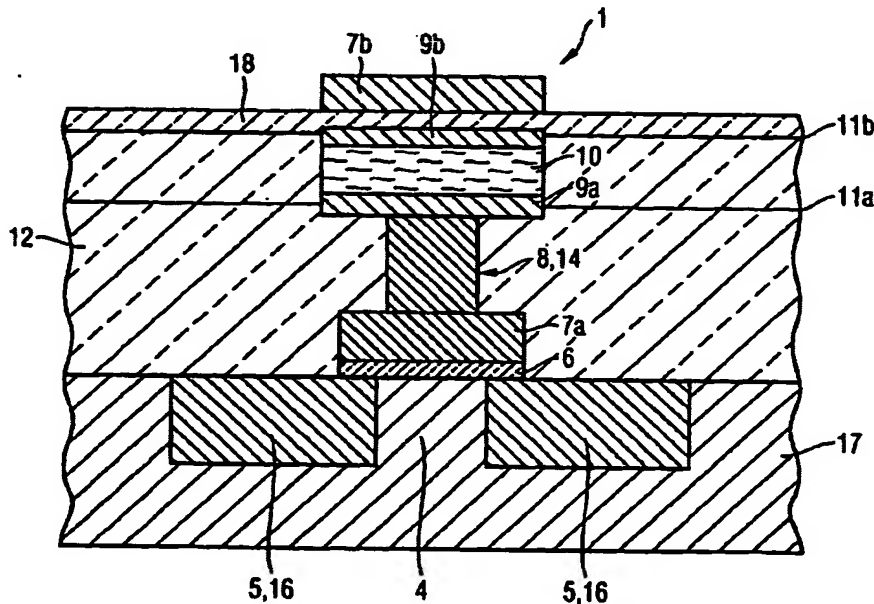
(74) Anwalt: KOTTMANN, Dieter; Patentanwälte, Müller
Hoffmann & Partner, Innere Wiener Str. 17, 81667
München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MEMORY CELL AND METHOD FOR PRODUCING A MEMORY

(54) Bezeichnung: SPEICHERZELLE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SPEICHEREINRICHTUNG



(57) Abstract: The invention concerns a method for producing a memory cell (1) comprising an organic storage layer (10), storing a digital information. Said method consists in carrying out a treatment of polycrystalline and monocrystalline semiconductor structures, during which said structures are subjected to high temperatures prior to applying the organic storage layer (10).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

BEST AVAILABLE COPY

WO 2005/010983 A2